



Высокая стойкость к
электротермоциклированию
Низкие статические и динамические потери
Разработан для промышленного
применения

Полупроводниковый Элемент Низкочастотного Тиристора Тип TG80-1250-44

Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии ¹⁾	I_{TAV}	1250 А		
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	U_{DRM}	3800...4400 В		
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	U_{RRM}			
Время выключения	t_q	630, 800 мкс		
$U_{DRM}, U_{RRM}, В$	3800	4000	4200	4400
Класс по напряжению	38	40	42	44
$T_{ij}, ^\circ C$	-60...+125			

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I_{TAV}	Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии ¹⁾	А	1250 1796	$T_c=101\text{ }^{\circ}\text{C}$; двухстороннее охлаждение; $T_c=85\text{ }^{\circ}\text{C}$; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TRMS}	Действующий ток в открытом состоянии ¹⁾	А	1962	$T_c=101\text{ }^{\circ}\text{C}$; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TSM}	Ударный ток в открытом состоянии ¹⁾	кА	37.0 43.0	$T_j=T_{j\text{ max}}$ $T_j=25\text{ }^{\circ}\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p=10\text{ мс}$; единичный импульс; $U_D=U_R=0\text{ В}$; Импульс управления: $I_G=2\text{ А}$; $t_{GP}=50\text{ мкс}$; $di_G/dt\geq 1\text{ А/мкс}$
			39.0 45.0	$T_j=T_{j\text{ max}}$ $T_j=25\text{ }^{\circ}\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p=8.3\text{ мс}$; единичный импульс; $U_D=U_R=0\text{ В}$; Импульс управления: $I_G=2\text{ А}$; $t_{GP}=50\text{ мкс}$; $di_G/dt\geq 1\text{ А/мкс}$
I^2t	Защитный показатель ¹⁾	A^2c10^3	6800 9200	$T_j=T_{j\text{ max}}$ $T_j=25\text{ }^{\circ}\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p=10\text{ мс}$; единичный импульс; $U_D=U_R=0\text{ В}$; Импульс управления: $I_G=2\text{ А}$; $t_{GP}=50\text{ мкс}$; $di_G/dt\geq 1\text{ А/мкс}$
			6300 8400	$T_j=T_{j\text{ max}}$ $T_j=25\text{ }^{\circ}\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p=8.3\text{ мс}$; единичный импульс; $U_D=U_R=0\text{ В}$; Импульс управления: $I_G=2\text{ А}$; $t_{GP}=50\text{ мкс}$; $di_G/dt\geq 1\text{ А/мкс}$

Блокирующие параметры				
U_{DRM}, U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	3800...4400	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто
U_{DSM}, U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	3900...4500	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$; 180 эл. град. синус; единичный импульс; управление разомкнуто
U_D, U_R	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	В	$0.6 \cdot U_{DRM}$ $0.6 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_{j\max}$; управление разомкнуто
Параметры управления				
I_{FGM}	Максимальный прямой ток управления	А	10	$T_j = T_{j\max}$
U_{RGM}	Максимальное обратное напряжение управления	В	5	
P_G	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	5	$T_j = T_{j\max}$ для постоянного тока управления
Параметры переключения				
$(di/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ($f=1$ Hz)	А/мкс	1250	$T_j = T_{j\max}$; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; $I_{TM} = 7000$ А; Импульс управления: $I_G = 2$ А; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt \geq 2$ А/мкс
Тепловые параметры				
T_{stg}	Температура хранения	°C	-60...+50	
T_j	Температура р-п перехода	°C	-60...+125	
Механические параметры				
F	Монтажное усилие ¹⁾	кН	40.0...50.0	
F_{cg}	Усилие на область управления	Н	7.8	

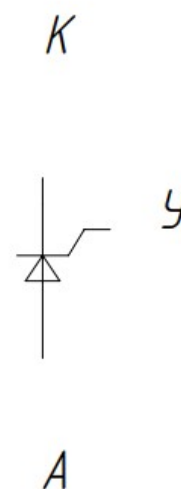
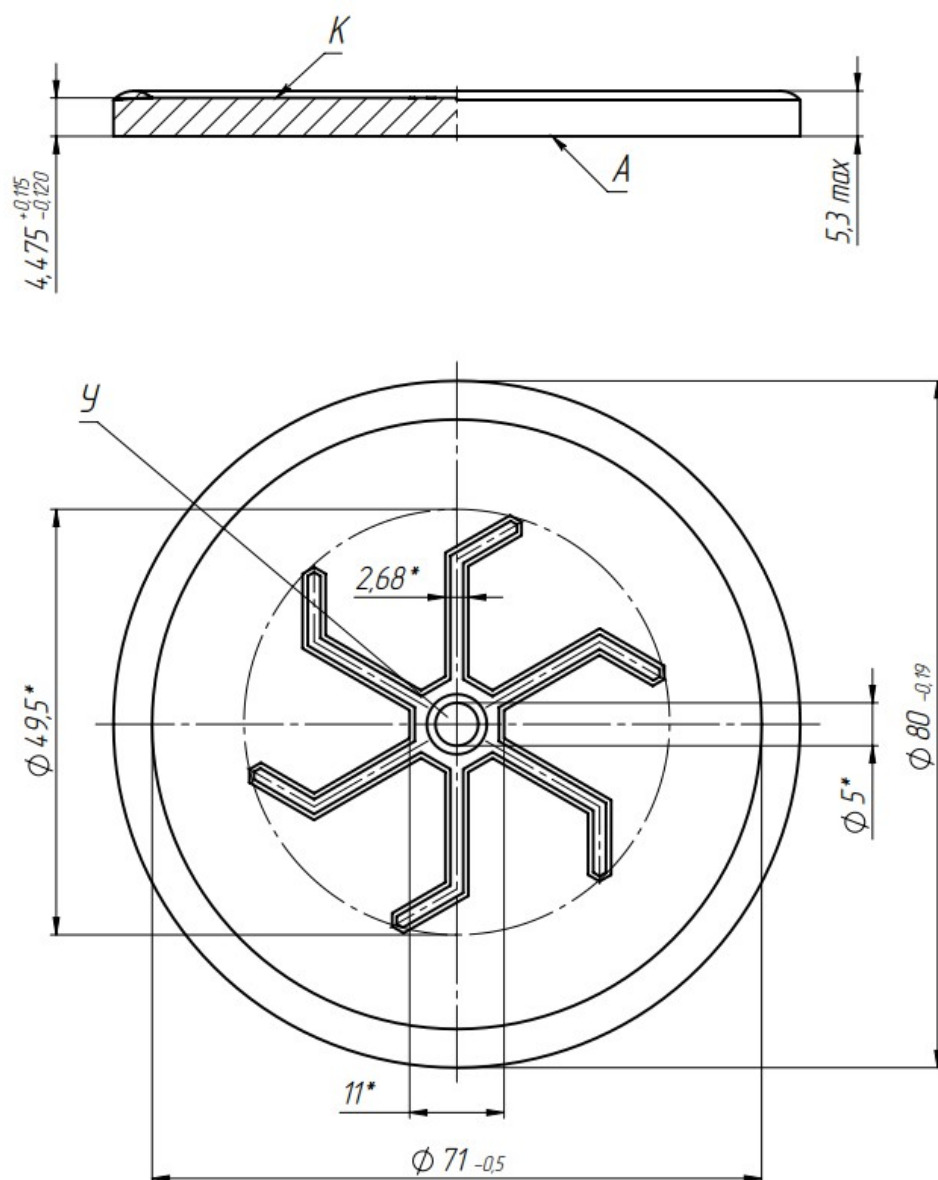
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения
Характеристики в проводящем состоянии				
U_{TM}	Импульсное напряжение в открытом состоянии ¹⁾ , макс	В	2.10	$T_j = 25$ °C; $I_{TM} = 3925$ А
$U_{T(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	В	1.164	$T_j = T_{j\max}$; $0.5 \pi I_{TAV} < I_T < 1.5 \pi I_{TAV}$
r_T	Динамическое сопротивление в открытом состоянии ¹⁾ , макс	МОм	0.331	
I_L	Ток включения, макс	мА	1500	$T_j = 25$ °C; $U_D = 12$ В; Импульс управления: $I_G = 2$ А; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt \geq 1$ А/мкс
I_H	Ток удержания, макс	мА	300	$T_j = 25$ °C; $U_D = 12$ В; управление разомкнуто
Блокирующие характеристики				
I_{DRM}, I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, макс	мА	300	$T_j = T_{j\max}$; $U_D = U_{DRM}$; $U_R = U_{RRM}$
$(du_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии ²⁾ , мин	В/мкс	200, 320, 500, 1000, 1600, 2000, 2500	$T_j = T_{j\max}$; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; управление разомкнуто

Характеристики управления					
U _{GT}	Отпирющее постоянное напряжение управления, макс	В	3.00 2.50 1.50	T _j = T _{j min} T _j =25 °C T _j = T _{j max}	U _D =12 В; I _D =3 А; Постоянный ток управления
I _{GT}	Отпирющий постоянный ток управления, макс	мА	400 250 150	T _j = T _{j min} T _j = 25 °C T _j = T _{j max}	
U _{GD}	Неотпирющее постоянное напряжение управления, мин	В	0.40	T _j =T _{j max} ;	
I _{GD}	Неотпирющий постоянный ток управления, мин	мА	45.00	U _D =0.67·U _{DRM} ; Постоянный ток управления	
Динамические характеристики					
t _{gd}	Время задержки, макс	мкс	2.75	T _j =25 °C; U _D =1500 В; I _{TM} =I _{TAV} ;	
t _{gt}	Время включения, макс	мкс	12.0	di/dt=200 А/мкс; Импульс управления: I _G =2 А; U _G =20 В; t _{GP} =50 мкс; di _G /dt=2 А/мкс	
t _q	Время выключения ³⁾ , макс	мкс	630, 800	du _D /dt=50 В/мкс; T _j =T _{j max} ; I _{TM} =I _{TAV} ; di _R /dt=-5 А/мкс; U _R =100 В; U _D =0.67·U _{DRM} ;	
Тепловые характеристики					
R _{thjc}	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус ¹⁾ , макс	°C/Вт	0.0085	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение
R _{thjc-A}			0.0187		Охлаждение со стороны анода
R _{thjc-K}			0.0153		Охлаждение со стороны катода
Механические характеристики					
m	Масса, макс	г	245		

МАРКИРОВКА						ПРИМЕЧАНИЕ																							
TG	80	1250	44	A2	B2	1) В зависимости от характеристик применяемого корпуса. Указанные значения актуальны при использовании корпуса Протон-Электротекс Т.Е1. 2) Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии <table><tr><th>Обозначение группы</th><th>P2</th><th>K2</th><th>E2</th><th>A2</th><th>T1</th><th>P1</th><th>M1</th></tr><tr><td>(du_D/dt)_{crit}, В/мкс</td><td>200</td><td>320</td><td>500</td><td>1000</td><td>1600</td><td>2000</td><td>2500</td></tr></table> 3) Время выключения (du_D/dt=50 В/мкс) <table><tr><th>Обозначение группы</th><th>C2</th><th>B2</th></tr><tr><td>t_q, мкс</td><td>630</td><td>800</td></tr></table>		Обозначение группы	P2	K2	E2	A2	T1	P1	M1	(du _D /dt) _{crit} , В/мкс	200	320	500	1000	1600	2000	2500	Обозначение группы	C2	B2	t _q , мкс	630	800
Обозначение группы	P2	K2	E2	A2	T1			P1	M1																				
(du _D /dt) _{crit} , В/мкс	200	320	500	1000	1600	2000	2500																						
Обозначение группы	C2	B2																											
t _q , мкс	630	800																											
1	2	3	4	5	6																								
1. ППЭ Низкочастотного Тиристора с разветвленной топологией управляющего электрода 2. Максимальный диаметр, мм 3. Средний ток в открытом состоянии, А 4. Класс по напряжению 5. Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкс 6. Группа по времени выключения (du_D/dt=50 В/мкс)																													

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



**Размеры для справок.*

Все размеры в миллиметрах

Содержащаяся здесь информация является конфиденциальной и находится под защитой авторских прав. В интересах улучшения качества продукции, АО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право изменять информационные листы без уведомления.